

广东省粤晶高科股份有限公司

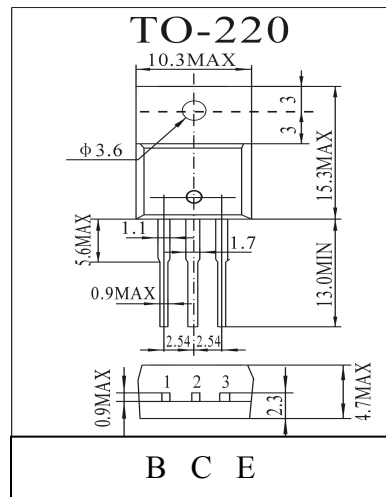
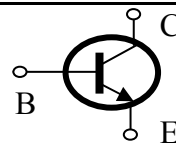
NPN 硅双极晶体管

D13007

■ 主要用途：用于电子节能灯、电子镇流器等功率开关电路。

■ 绝对最大额定值（ $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数名称		符号	额定值	单位
集电极-基极电压		VCBO	700	V
集电极-发射极电压		VCEO	400	V
发射极-基极电压		VEBO	9	V
集电极电流		IC	8	A
基极电流		IB	4	A
集电极 耗散功率	($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	Pd	80	W
	($T_a=25^{\circ}\text{C}$)		2	
结 温		Tj	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		Tstg	-55-150	$^{\circ}\text{C}$



■ 电参数（ $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
共发射极直流电流增益	HFE(1)	$V_{ce}=5\text{ V}, I_c=2\text{ A}$	8		60	β 值
集电极-基极击穿电压	BVcbo	$I_c=1\text{ mA}, I_e=0$	700			V
集电极-发射极击穿电压	BVceo	$I_c=10\text{ mA}, I_b=0$	400			V
发射极-基极击穿电压	BVebo	$I_e=1\text{ mA}, I_c=0$	9			V
集电极-基极截止电流	Icbo	$V_{cb}=700\text{ V}, I_e=0$			1	mA
发射极-基极截止电流	Iebo	$V_{eb}=9\text{ V}, I_c=0$			1	mA
集电极-发射极饱和压降	$V_{ce(sat)}$	$I_c=5\text{ A}, I_b=1\text{ A}$			2	V
基极-发射极饱和压降	$V_{be(sat)}$	$I_c=5\text{ A}, I_b=1\text{ A}$			1.6	V
特征频率	f _r	$V_{ce}=10\text{ V}, I_c=500\text{ mA}, f=1.0\text{ MHz}$	4			MHz
导通时间	ton	$V_{ce}=10\text{ V}, I_c=2\text{ A}, I_{B1}=I_{B2}=400\text{ mA}$			1.6	μS
存贮时间	ts				3.5	μS
下降时间	tf				0.7	μS

■ HFE(1)分档及其标识

打印标识	D13007				
分 档	A	B	C	D	E
HFE(1)	8-25	20-35	30-45	40-55	50-60

QR027